

D4SBN20

200V 4A

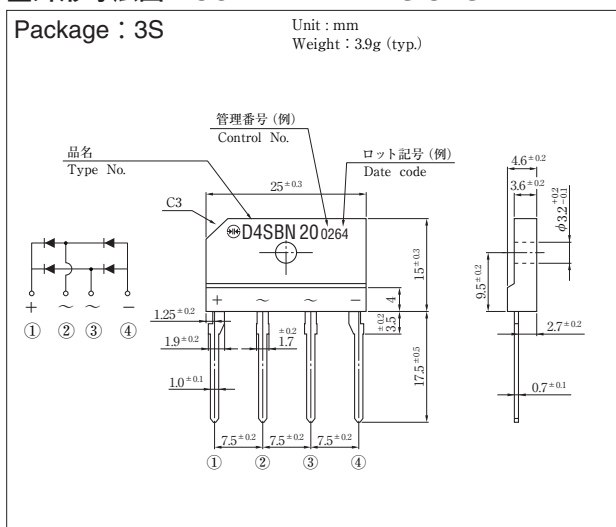
特長

- 薄型SIPパッケージ
- SBDブリッジ
- 低 V_F ・低 I_R

Feature

- Thin-SIP
- SBD Bridge
- Low V_F · Low I_R

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

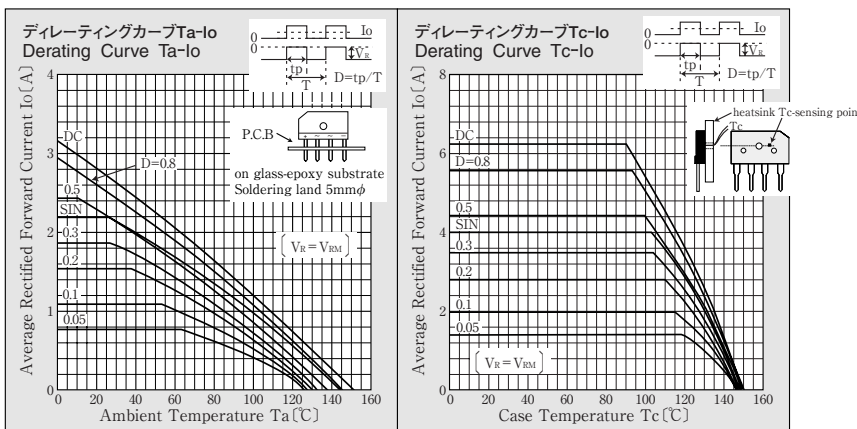
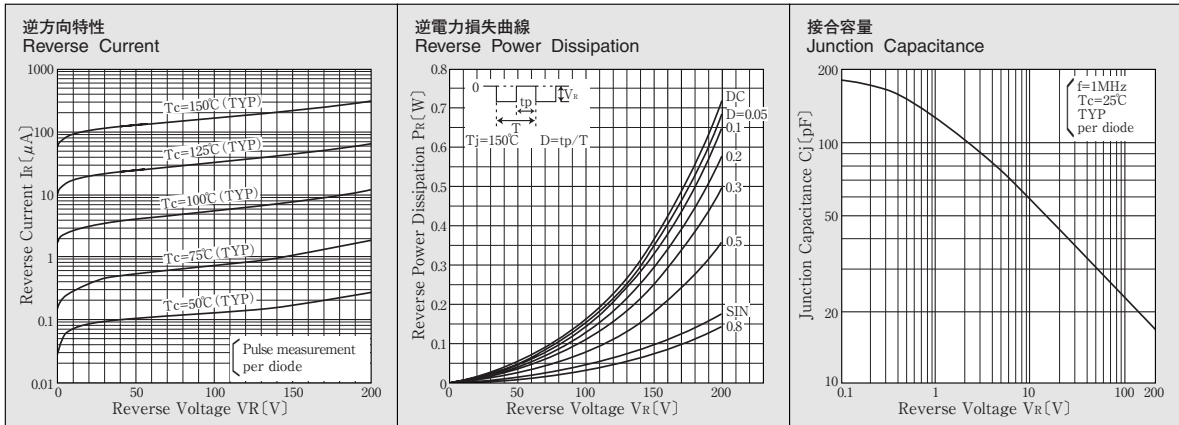
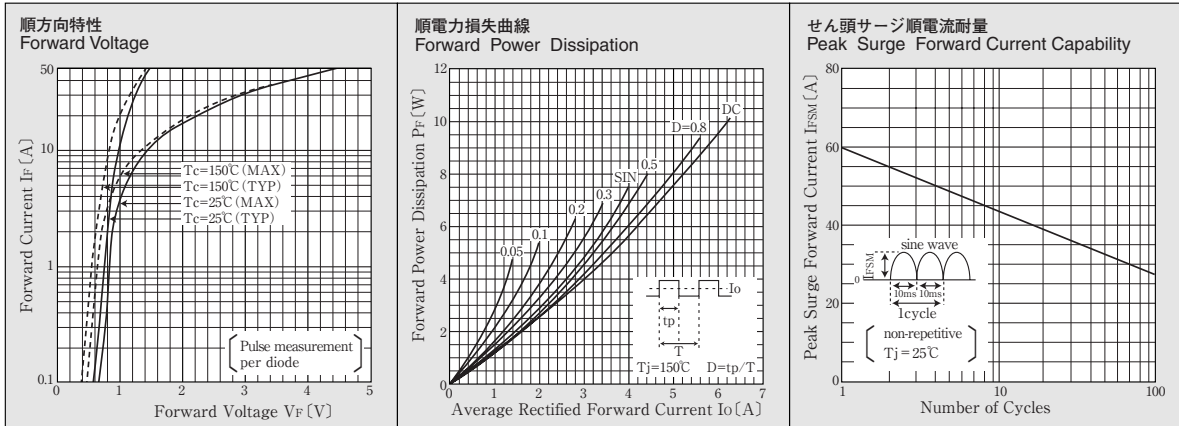
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_C=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D4SBN20	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	$^\circ\text{C}$	
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$	
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	V	
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	$T_C=103^\circ\text{C}$	4.0	A
			フィンなし Without heatsink	$T_a=25^\circ\text{C}$	2.2	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$			60	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V_{dis}	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute			2.0	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque: 0.5 N·m)			0.8	N·m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_C=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F=2\text{A}$, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX	0.90	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R=200\text{V}$, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX	1.5	μA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f=1\text{MHz}$, $V_R=10\text{V}$, 一素子当たりの規格値 per diode	TYP	60	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間, フィン付き junction to case, With heatsink	MAX	6.0	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{jl}	接合部・リード間 junction to lead	MAX	8.0	
	θ_{ja}	接合部・周囲間 junction to ambient	MAX	35	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.